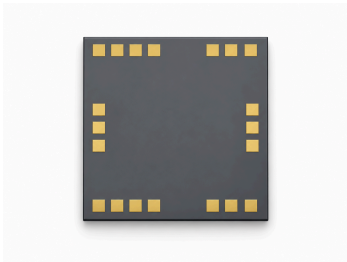


100–20000 MHz GaAs SP3T-MMIC-Schalter als Bare Die — $IL \leq 2.8 \text{ dB}$ (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; Einfügedämpfung (100–2000 MHz) $\leq 1.4 \text{ dB}$; Isolation (100–2000 MHz) $\leq 65 \text{ dB}$.



RF-Kennwerte · $T_A = +25 \text{ }^\circ\text{C}$

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Betriebsfrequenz	f	100	-	20000	100–20000	MHz
Einfügedämpfung (100–2000 MHz)	-	-	-	1.4	f = 100–2000 MHz	dB
Einfügedämpfung (2000–20000 MHz)	-	-	-	2.8	f = 2000–20000 MHz	dB
Isolation (100–2000 MHz)	-	-	-	65	f = 100–2000 MHz	dB
Isolation (2000–20000 MHz)	-	-	-	43	f = 2000–20000 MHz	dB
Ein-/Ausgangs-VSWR (leitend)	-	-	1.2	-	-	-
Ein-/Ausgangs-VSWR (gesperrt)	-	-	1.4	-	-	-
Eingangsleistung bei 1 dB Kompression	-	23	-	-	-	dBm

Steuerspannungen · $T_A = +25 \text{ }^\circ\text{C}$

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit	Hinweise
Ruhestrom der negativen Versorgung	-	-	-	0.002	A	-
Eingangssteuerstrom	-	-	0.0002	-	A	TTL = +5 V
High-Eingangsspannung	-	3	-	5.5	V	-
Low-Eingangsspannung	-	0	-	0.8	V	-
Negative Versorgungsspannung	-	-5.5	-5	-4.5	V	-

Grenzwerte · Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	25	dBm
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Betriebstemperatur	-	-55	-	125	°C
Minimale negative Versorgungsspannung	-	-6	-	-	V

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	1.5 × 1.55 × 0.1	mm
Toleranz der Draufsichtkontur	±100	µm

Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	mm
2	RFin	0.100 × 0.100
9	RF1	0.100 × 0.100
12	RF2	0.100 × 0.100
15	RF3	0.100 × 0.100
4, 20	VEE	0.100 × 0.100
5, 7	A1	0.100 × 0.100
17, 19	B1	0.100 × 0.100
6	A2	0.100 × 0.100
18	B2	0.100 × 0.100
1, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 16	GND	0.100 × 0.100

Aktueller Publikationsstand · 1.4 · 2026-10-27. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.3.

Integrationshinweise

A1 / B1 (V) = 0; A2 / B2 (V) = 0; RF = RFin ↔ RF1 A1 / B1 (V) = 0; A2 / B2 (V) = 5; RF = RFin ↔ RF2 A1 / B1 (V) = 5; A2 / B2 (V) = 5; RF = RFin ↔ RF3

Anschluss der Bondpads

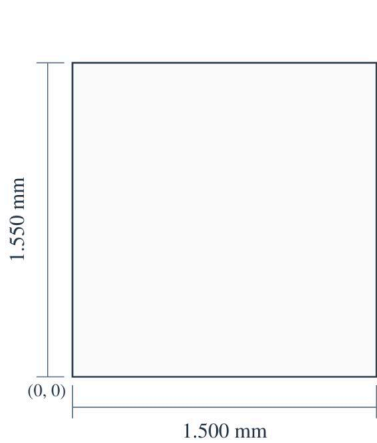
Die gekennzeichneten GND-Pads dienen als Test-Massepads. Für VEE genügt ein Pad aus 4, 20. Für A1 / B1 genügt ein Pad aus 5, 7, 17, 19. Für A2 / B2 genügt ein Pad aus 6, 18.

Geltungsbereich der mechanischen Referenz

Quellenbasierte Umrissdarstellung mit ausdrücklich bemaßten Koordinaten in mm. Keine vollständige Fertigungs- oder Bonddrahtzeichnung.

Mechanische Maßzeichnung

LCI-SW-100-20000-SP3T-D



X (mm)
VEE: 0.125
A1 / B1 (5, 19): 0.275
A2 / B2: 0.425
A1 / B1 (7, 17): 0.575
RF1 / RF3: 1.200

Y (mm)
RFin / RF2: 0.775

1.500 × 1.550 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

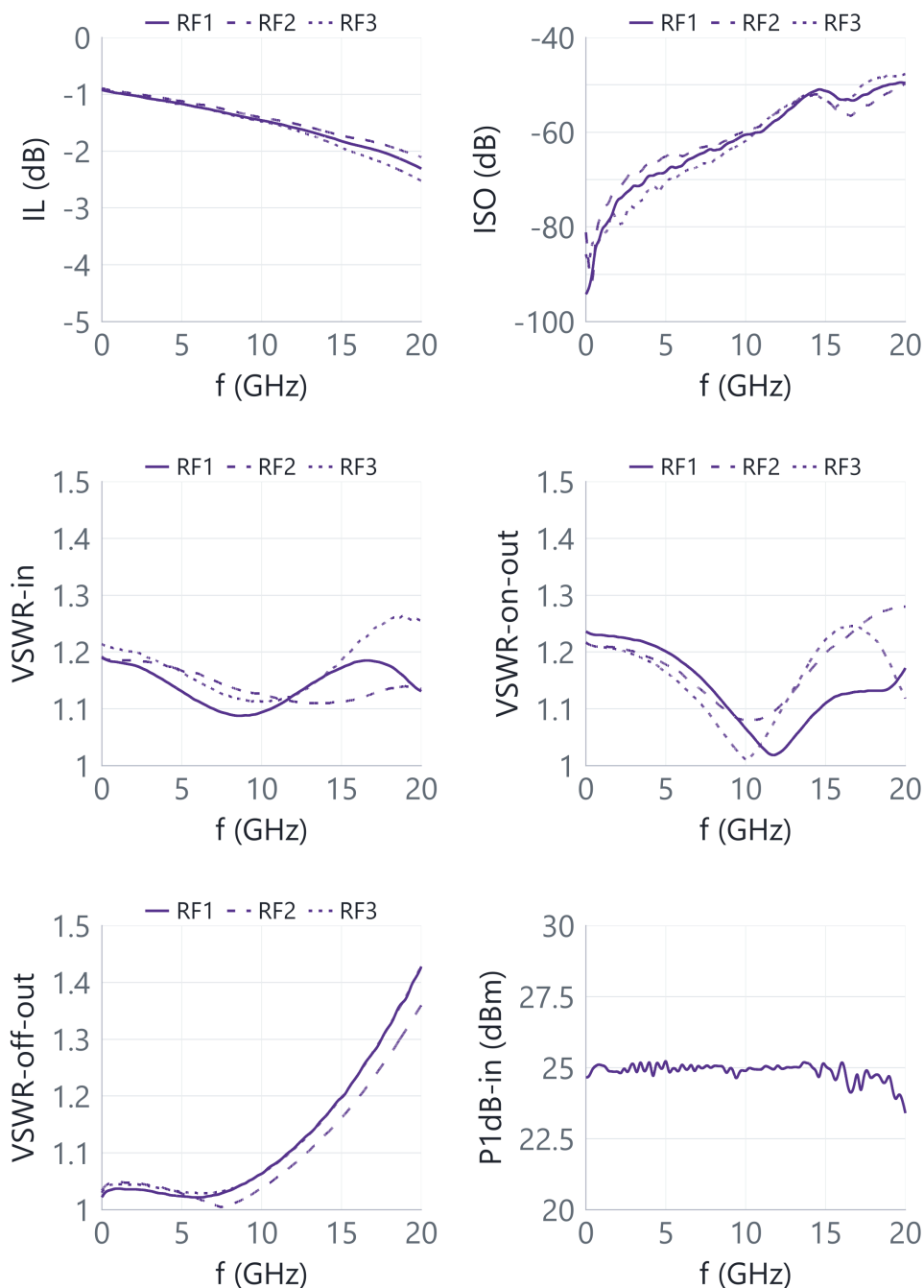
Alle Maße in mm [in].

Kennlinien

Diagramme aus dem ursprünglichen Datenblatt. Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

Ausgangsanpassung; Eingangsanpassung; Isolation; Einfügedämpfung; Eingangsleistung bei 1 dB Kompression.

Nach der Originalgrafik neu gezeichnet; die ablesbaren Werte sind Näherungswerte.



[Quelle](#)

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.